



NPN高压开关晶体管/NPN High Voltage Switching Transistor

●特点: ■击穿电压稳定 ■开关速度快 ■安全工作区宽 ■符合ROHS规范

●FEATURES: ■HIGH VOLTAGE CAPABILITY ■HIGH SPEED SWITCHING ■WIDE SOA ■ROHS COMPLIANT

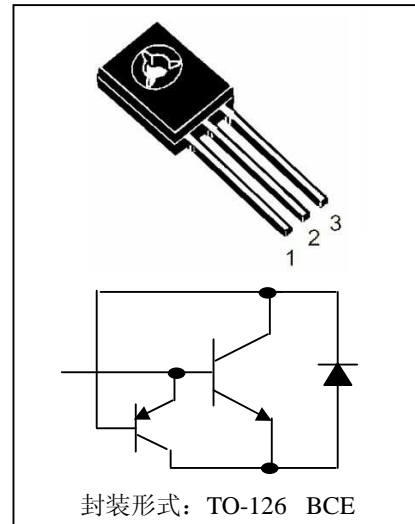
●应用 ■节能灯 ■电子镇流器 ■电子变压器等开关电路

●APPLICATION: ■FLUORESCENT LAMP ■ELECTRONIC BALLAST ■ELECTRONIC TRANSFORMER ECT.

●最大额定值 (TC=25°C)

●Absolute Maximum Ratings (Tc=25°C)

| 参数名称 PARAMETER | 符号 SYMBOL | 额定值 VALUE | 单位 UNIT |
|--|--------------|--------------|------------|
| 集电极-基极电压 Collector-Base Voltage | VCBO | 600 | V |
| 集电极-发射极电压 Collector-Emitter Voltage | VCEO | 410 | V |
| 发射极-基极 Emitter-Base Voltage | VEBO | 9 | V |
| 集电极电流 Collector Current | Ic | 1.5 | A |
| 集电极耗散功率 Total Power Dissipation | PC | 23 | W |
| 最高工作温度 Junction Temperature | Tj | 150 | °C |
| 贮存温度 Storage Temperature | TsTg | -55-150 | °C |



电特性 (TC=25°C)

Electrical Characteristics (Tc=25°C)

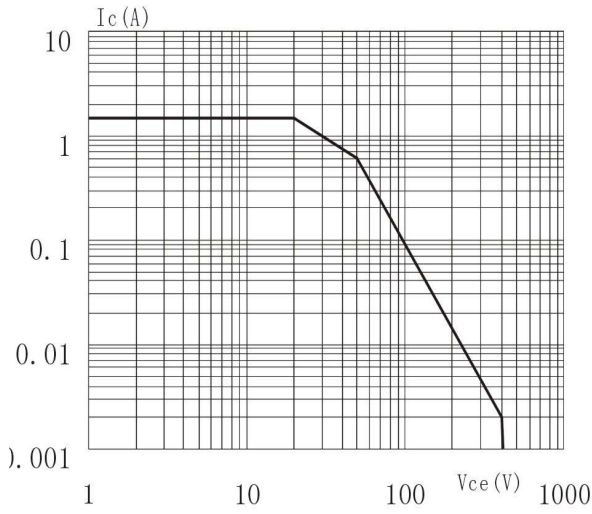
| 参数名称 CHARACTERISTICS | 符号 SYMBOL | 测试条件 TEST CONDITION | 最小值 MIN | 最大值 MAX | 单位 UNIT |
|---|--------------|--------------------------------|------------|------------|------------|
| 集电极-发射极截止电流 Collector-Emitter Cutoff Current | ICEO | VCE=400V, IB=0 | | 10 | uA |
| 集电极-发射极电压 Collector-Emitter Voltage | VCEO | IC=10mA, IB=0 | 410 | | V |
| 发射极-基极电压 Collector-Base Voltage | VEBO | IE=1mA, IC=0 | 9 | | V |
| 集电极-发射极饱和压降 Collector-Emitter Saturation Voltage | Vcesat | IC=0.5A, IB=0.1A | | 0.35 | V |
| | | IC=1.5A, IB=0.5A | | 0.7 | V |
| 发射极-基极饱和压降 Base-Emitter Saturation Voltage | Vbesat | IC=1.5A, IB=0.5A | | 1.2 | V |
| 电流放大倍数 DC Current Gain | Hfe | VCE=5V, IC=200uA | 8 | | |
| | | VCE=10V, IC=250mA | 15 | 30 | |
| | | VCE=5V, IC=1.5A | 6 | | |
| 贮存时间 Storage Time | ts | VCC=5V IC=0.25A (UI9600) | 2 | 3.5 | us |
| 下降时间 falling time | tf | | | 0.8 | |
| 内置二极管正向压降 Diode Forward Voltage | Vf | IC=1.5A | | 2.0 | V |

注意事项: 1、使用时不要外接续流保护二极管

2、基极驱动电流应较强, 确保不出现基极驱动不足, 但也不能太强, 超过PNP管的控制范围。



SOA(DC)



$P_c \propto T_j$

